

## 실리콘 분말로부터 질화 실리콘 합성연구

(A Synthesis of Silicon Nitride from Silicon Powder)

충남대학교 응고 신소재 연구소 '안성권 주성민 원창환  
한국 자원 연구소 손용운'

### 1. 서 론:

질화실리콘의 합성방법은 구성요소들로부터의 합성법, 실리콘과 암모니아의 휘발성 합성물 사이의 반응을 이용하는 합성법으로 구분 할 수 있다. 이들 방법 중 본 연구에서는 실리콘 분말과 질소가스와의 직접 질화반응법에 의해 질화실리콘을 합성하는 방법을 연구 검토하였다. 이 직접 질화반응법의 장점은 당량 및 비당량의 질화실리콘을 임의대로 만들 수 있다.

### 2. 실험 방법:

본 실험에서는 금속실리콘 분말로 부터 합성실험에 기본인자가 되는 반응온도, 시간, 유량 등 의 반응조건을 변화시켜 당량 및 비당량의 질화실리콘의 합성에 미치는 영향을 검토 하였다.

### 3. 실험 결과 및 고찰:

금속실리콘의 분말의 경우 반응온도가 950°C의 경우, 질소가스에 의해 당량의 질화실리콘의 합성은 수시간 안에 질화층을 형성한다. 반응온도가 이보다 낮은 경우에는 당량의 질화실리콘의 질화층을 형성하는데는 장시간이 소요된다. 한편 금속실리콘과 질소가스에 의해 질화물을 형성한 다음, 균질화소둔을 행하면 균질화된 당량 및 비당량의 질화실리콘을 제조 할 수가 있다. 균질화 처리는 알곤 분위기하에서 균질화온도 및 시간등에 대한 영향을 비교하였다.

### 4. 결론:

금속실리콘과 질소가스와의 직접 반응후에 알곤 분위기하에서 균질화 소둔 처리에 의해 질화실리콘의 합성 실험을 한 결과, 당량 및 비당량의 질화실리콘을 용이하게 얻을 수 있었다. 이렇게 합성된 질화실리콘의 산물과 시약급의 질화실리콘과 상호 비교 분석 결과 거의 동일한 산물을 합성 할 수 있었다.

### 5. 참고문헌:

- 1) J.Mukerji & K.K.Dhargupta. *Indian J Technol* **16**, 156-60 (1978).
- 2) S.K.Biswas & J. Mukerji. *J Am Ceram Soc* **63**, 232-3 (1980).
- 3) W.A.Fate & M.E.Milberg. *J Am Ceram Soc* **61**, 531-2 (1978).
- 4) S.K.Biswas & J. Mukerji. *Mater Res Bull* **19**, 401-6 (1984).